



®

DHA ®

QJ/DHA 09.22-2018

70N06

N-沟道 MOSFET 功率晶体管

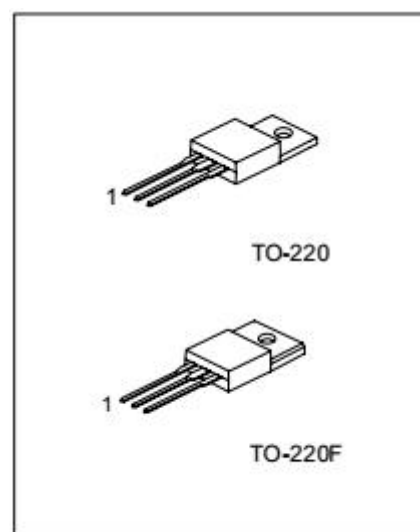
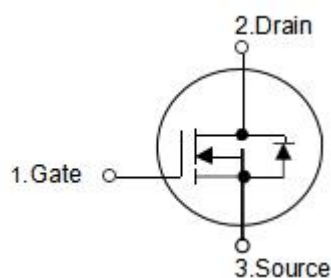
描述

70N06 是 N 沟道增强型功率场效应晶体管，具有稳定的关断特性，快速开关速度，低热阻。

用途

通常用于电信和计算机应用。

等效电路图



电参数 (Tamb = 25℃)

缩写	参数	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
BV _{DSS}	漏极-源极 击穿电压	V	60	—	—	V _{GS} =0 V, I _D =250 μA
I _D	漏极连续电流	A	—	—	70.0	T _j = 25 °C
R _{DS(on)}	静态 漏极-源极 导通电阻	m Ω	—	12	15	V _{GS} =10 V, I _D =35 A
V _{GS(th)}	栅极门限电压	V	2.0	—	4.0	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μA
I _{DSS}	漏极-源极 漏电流	μA	—	—	1	V _{DS} = 60 V, V _{GS} = 0 V
I _{GSS}	栅极-源极 漏电流	nA	—	—	100	V _{GS} = ± 20 V, V _{DS} = 0 V
T _j	工作结温	°C	- 55 ~ +150			
T _{STG}	储存温度范围	°C				